

(11)Publication number:

2002-199719

(43)Date of publication of application: 12.07.2002

(51)Int.CI.

HO2M 3/28

(21)Application number : 2000-395836

(71)Applicant : DENSEI LAMBDA KK

(22)Date of filing:

26.12.2000

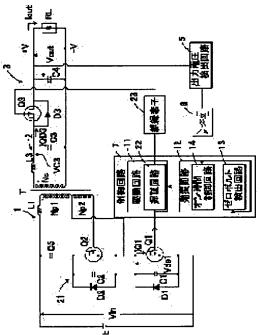
(72)Inventor: KOIKE MASAHIRO

## (54) COMPOSITE RESONANCE TYPE SWITCHING POWER SUPPLY

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce a loss caused by a secondary side rectifying unit of an insulated converter transformer.

SOLUTION: A sinusoidal pulse waveform is given to a voltage, between both terminals of a main switching device Q1 by a voltage resonance circuit 1 on the primary side of an insulated converter transformer T to carry out ZVS of the main switching device Q1. An alternating voltage, obtained from the secondary winding Ns of the insulated converter transformer T, is converted into a resonance voltage of a sinusoidal waveform by a voltage resonance circuit 3, on the secondary side of the insulated converter transformer T. Since a rectifying switching device Q3 is used as a rectifier, comprising the secondary side rectifying unit, even if an output voltage Vout is low, the efficiency of the secondary side rectifying unit will not decline so much. HOW IN C. HEAD OF THE STEEL S. S.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

THIS PAGE BLANK (USPTO)

and the state of t

(19) 日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報 (A) (11) 特許出願公開番号

特開2002-199719 (P2002-199719A) (43)公開日 平成14年7月12日(2002.7.12)

(51) Int. C I. 7

H 0 2 M

3/28

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

H 0 2 M 3/28 Q 5H730

Η

審査請求 未請求 請求項の数2

ΟL

(全7頁)

(21)出願番号

特願2000-395836 (P2000-395836)

(22) 出願日

平成12年12月26日(2000.12.26)

(71) 出願人 390013723

デンセイ・ラムダ株式会社

東京都品川区東五反田一丁目11番15号 電

波ピルディング

(72) 発明者 小池 昌宏

東京都品川区東五反田1-11-15 デンセ

イ・ラムダ株式会社内

(74)代理人 100080089

弁理士 牛木 護

F ターム(参考) 5H730 AA14 AS01 BB23 BB57 BB72

DD04 DD41 EE02 EE07 EE14

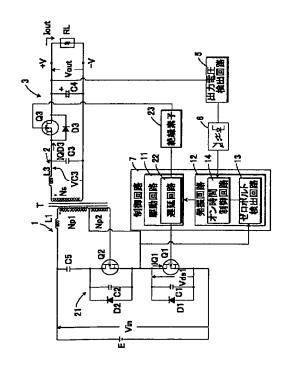
FD01 FF19 FG03

#### (54) 【発明の名称】複合共振型スイッチング電源装置

#### (57) 【要約】

【課題】 絶縁コンバータトランスの二次側整流部によ る損失を低減し、効率の向上を図る。

【解決手段】 絶縁コンバータトランスTの一次側にあ る電圧共振回路lにより、主スイッチング素子Qlの両 端間電圧を正弦波状のパルス波形にし、主スイッチング 素子Q1のZVSを行なう。また、絶縁コンバータトラ ンスTの二次側にある電圧共振回路 2 により、絶縁コン バータトランスTの二次巻線Nsに得られる交番電圧を 正弦波状の共振電圧にする。絶縁コンバータトランスT の二次側整流部を構成する整流素子として、整流スイッ チング素子Q3を用いることで、出力電圧Voutが低く ても二次側整流部の効率はさほど低下しない。



10

20

30

1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 主スイッチング素子のスイッチングにより絶縁コンバータトランスの一次巻線に直流入力電圧を断続的に印加し、この絶縁コンバータトランスの二次巻線に誘起された交番電圧を整流平滑して所望の直流出力電圧を得ると共に、前記絶縁コンバータトランスの一次側と二次側にそれぞれ共振回路を有する複合共振型スイッチング電源装置において、前記絶縁コンバータトランスの二次側にある整流素子として、前記主スイッチング素子に同期してオン・オフする整流スイッチング素子を備えたことを特徴とする複合共振型スイッチング電源装置。

【請求項2】 前記主スイッチング素子のオフ期間に、この主スイッチング素子の両端間電圧を一定に保つアクティブクランプ回路を備えたことを特徴とする請求項1記載の複合共振型スイッチング電源装置。

#### 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、絶縁コンバータトランスの一次側と二次側にそれぞれ電圧共振回路または電流共振回路を有する複合共振型スイッチング電源装置に関する。

#### [0002]

【発明が解決しようとする課題】従来、スイッチング素子のスイッチングにより絶縁コンバータトランスの一次巻線に直流入力電圧を断続的に印加し、この絶縁コンバータトランスの二次巻線に誘起された交番電圧を整流平滑して所望の直流出力電圧を得るスイッチング電源装置においては、スイッチング素子がオフの期間にこのスイッチング素子の両端間に加わる電圧を電圧共振回路によって正弦波状にし、スイッチング素子のターンオンおよびターンオフ時における損失やサージを低減する電圧共振型スイッチング電源装置が知られている。また近年は、絶縁コンバータトランスの一次側のみならず二次側にも電圧共振回路を設けて、最大負荷電力の増加を図ると共に、スイッチング素子の周波数と導通角を同時に制御して、出力電圧の安定化を図る複合電圧共振型スイッチング電源装置も提案されている。

【0003】図3は、従来の複合電圧共振型スイッチング電源装置における回路図の一例を示したもので、ここでは、1石のスイッチング素子Q1を備えた他励式の構成を有している。同図において、Eは直流入力電圧Vinを供給する直流電源、Tは一次側と二次側とを絶縁する絶縁コンバータトランス、Q1は例えばMOS型FETからなる第1のスイッチング素子で、絶縁コンバータトランスTの一次側は、直流電源Eの両端間にトランスTの一次巻線Npとスイッチング素子Q1の直列回路を接続したシングルエンデット型のコンバータで構成される。また、スイッチング素子Q1の両端すなわちドレイン・ソース間には、一次側世にコンデンサC1トがイナ

ードD1が並列に接続される。この共振コンデンサC1 はスイッチング素子Q1に内蔵する寄生キャパシタンス であり、またダイオードDlはスイッチング素子Qlに 内蔵するボディダイオードであるが、外付けのコンデン サ素子やダイオード素子を用いてもよい。また、絶縁コ ンバータトランスTの一次側には、前記共振コンデンサ C1と共に一次側電圧共振回路1を構成する一次側共振 インダクタンスL1が、一次巻線Npの一端に接続され る。この共振インダクタンスし1は、絶縁コンバータト ランスTのリーケージインダクタンスを利用している が、外付けのインダクタンス素子を利用してもよい。そ して、絶縁コンバータトランスTの一次側では、スイッ チング素子Q1のスイッチングにより一次巻線Npに入 力電圧Vinが断続的に印加されると共に、スイッチング 素子Q1のオフ時には、前記電圧共振回路1の作用によ って、共振コンデンサClひいてはスイッチング素子Q 1の両端間電圧を正弦波状のパルス波形にし、電圧共振 としての動作を得るようにしている。

【0004】絶縁コンバータトランス丁は、スイッチン グ素子Q1のスイッチング出力を二次側に伝送するため のもので、絶縁コンバータトランスTの二次巻線Nsに は、一次巻線Npとの巻数比に応じた交番電圧が誘起さ れる。また、この二次巻線Nsには、二次側共振インダ クタンスL3と二次側共振コンデンサC3との直列回路 が、二次側電圧共振回路2として並列に接続され、この 電圧共振回路2によって、絶縁コンバータトランスTの 二次巻線Nsに得られる交番電圧を共振電圧にし、電圧 共振としての動作を得るようにしている。なお、この場 合の共振インダクタンスL3は、絶縁コンバータトラン スTのリーケージインダクタンスを利用しているが、外 付けのインダクタンス素子を利用してもよい。共振コン デンサC3の両端間には、整流ダイオードD5と平滑コ ンデンサC4とからなる半波整流平滑回路3が接続さ れ、前記共振電圧がこの半波整流平滑回路3により整流 平滑されることで、平滑コンデンサС4の両端間に接続 した出力端子+Vo, -Voひいては負荷RLに所望の 直流出力電圧Voutを得るようにしている。

【0005】一方、この出力電圧Voutの安定化を図るための帰還ループとして、出力電圧検出回路5と、信号伝送手段として一次側と二次側とを絶縁するフォトカプラ6と、スイッチング素子Q1の動作を制御する制御回路7がそれぞれ設けられる。出力電圧検出回路5は、出力電圧Voutを検出するもので、例えば出力電圧Voutを分圧する抵抗と、この抵抗の接続点から出力する出力電圧Voutの検出電圧と基準電圧とを比較する誤差増幅器またはシャントレギュレータなどから構成され、検出電圧と基準電圧との誤差結果を、フォトカプラ6を介して後述する制御回路7のオン時間制御回路14に、出力電圧Voutの誤差増幅信号として出力するようにしている。また制御回路7は、発振回路12と、この発振回路13から

ン・ソース間には、一次側共振コンデンサC1とダイオ 50 また制御回路7は、発振回路12と、この発振回路12から

(3)

20

3

のパルス波形を駆動信号としてスイッチング素子Q1に 出力する駆動回路11とを備えており、発振回路12は、主 スイッチング素子Qlのオフ時間を一定にする手段とし て、主スイッチング素子Q1の両端間がゼロボルトにな ったか否かを検出するゼロボルト検出回路13を備えると 共に、主スイッチング素子Qlのオン時間を出力電圧V outの誤差増幅信号に応じて可変するオン時間制御回路1 4を備えている。これにより、出力電圧 Voutの変動に伴 なってスイッチング素子Qlのゲートに供給するパルス 駆動信号のオン時間が所定の範囲で変化すると共に、こ のパルス駆動信号のオフ時間はゼロボルト検出回路13に より固定され、結果的にスイッチング素子Q1のスイッ チング周波数が可変制御される。これにより、広い制御 範囲において出力電圧Voutの定電圧化が図られる上 に、最大負荷電力の増大を図ることができる。

【0006】こうした複合電圧共振型スイッチング電源 装置は、出力電圧Voutが比較的高い高出力電圧に適し ている。すなわち、上記図3の回路構成において、絶縁 コンバータトランスTの二次側整流部の効率 nsは、半 波整流平滑回路 3 に整流ダイオード D 5 がある関係で、 次の数1のようにあらわせる。

[0007]

【数1】

$$\eta s = \frac{Vout \times Iout}{(Vout + VF) \times Iout}$$

【0008】但し、Voutは負荷RLの両端間に生じる 出力電圧、Ioutは二次巻線Nsから負荷RLに流れる負 荷電流、VFは整流ダイオードD5の順方向電圧降下で

【0009】上記数1の分母および分子を、Vout×Io utで割って整理すると、次の数2のようになる。

[0 0 1 0]

【数2】

$$\eta s = \frac{1}{1 + \frac{VF}{Vout}}$$

【0011】この場合、出力電圧Voutが高ければ高い 程、絶縁コンバータトランスTの二次側整流部の効率η sは理想的な1に近付くが、出力電圧Voutが低くなる 程、整流ダイオードD5の順方向電圧降下による影響が 無視できなくなって、効率 ηsが大きく低下する。した がって、この種の複合電圧共振型スイッチング電源装置 においては、出力電圧Voutを例えばDC2VやDC 3.3 Vなどに低電圧化しようとする際に、整流ダイオ ードD5の損失による効率 nsの低下が懸念されてい た。

【0012】本発明は、上記の課題に着目して成された ものであって、絶縁コンバータトランスの二次側整流部 型スイッチング電源装置を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】本発明の請求項1記載の 複合共振型スイッチング電源装置は、主スイッチング素 子のスイッチングにより絶縁コンバータトランスの一次 巻線に直流入力電圧を断続的に印加し、この絶縁コンバ ータトランスの二次巻線に誘起された交番電圧を整流平 滑して所望の直流出力電圧を得ると共に、前記絶縁コン バータトランスの一次側と二次側にそれぞれ共振回路を 10 有する複合電圧共振型スイッチング電源装置において、 前記絶縁コンバータトランスの二次側にある整流素子と して、前記主スイッチング素子に同期してオン・オフす る整流スイッチング素子を備えたものである。

【0014】絶縁コンバータトランスの一次側にある共 振回路により、主スイッチング素子を流れる電流または 両端間電圧を正弦波状のパルス波形にし、主スイッチン グ素子のソフトスイッチングを行なう。また、絶縁コン バータトランスの二次側にある別の共振回路によって、 絶縁コンバータトランスの二次巻線に得られる交番電圧 または二次巻線からの電流を正弦波状の共振電圧または 共振電流にする。その際、絶縁コンバータトランスの二 次側整流部を構成する整流素子として、ダイオード素子 ではなく整流スイッチング素子を用いているので、出力 電圧の低い複合共振型スイッチング電源装置であって も、二次側整流部の効率はさほど低下しない。よって、 従来に比べて絶縁コンバータトランスの二次側整流部に よる損失を低減し、効率の向上を図ることが可能にな

【0015】本発明の請求項2記載の複合共振型スイッ チング電源装置は、前記請求項1において、前記主スイ ッチング素子のオフ期間中に、この主スイッチング素子 の両端間電圧を一定に保つアクティブクランプ回路を備 えたことを特徴とする。

【0016】この場合、主スイッチング素子のオフ期間 には、アクティブクランプ回路により主スイッチング素 子の両端間電圧が一定に保たれる。したがって、主スイ ッチング素子のオフ期間において、この主スイッチング 素子の電圧ストレスを低減することが可能になる。

[0 0 1 7]

【発明の実施形態】以下、本発明の複合共振型スイッチ ング電源装置について添付図面を参照して説明する。な お、前記従来例における図3と同一部分には同一符号を 付し、その共通する箇所の説明は重複するため省略す る。装置の回路構成を示す図1において、絶縁コンバー タトランスTの一次側は、共振インダクタンスL1,一 次巻線NplおよびMOS型FETからなる主スイッチン グ素子Q1との直列回路が、直流電源Eの両端間に接続 されると共に、共振インダクタンスL1と一次巻線Npl との直列回路の両端間には、MOS型FETからなる補 による損失を低減し、効率の向上を図った複合電圧共振 50 助スイッチング素子Q2とコンデンサС5との直列回路 (4)

10

20

で構成されるアクティブクランプ回路21が接続される。 また絶縁コンバータトランスTは、入力電圧Vinが断続 的に印加される一次巻線Nplとは別に、補助スイッチン グ素子Q2のゲートに駆動電圧を供給する駆動巻線とし ての一次巻線Np2が別に設けられる。これにより、主ス イッチング素子Q1と補助スイッチング素子Q2は、双 方がオフになるデッドタイムを有しながら、交互にオン ・オフを繰り返すようになる。本実施例では、こうした 動作を一次巻線Np2により行なわせているが、例えば駆 動回路11から出力されるパルス駆動信号を適当なデッド タイムを持たせて反転させ、この反転した駆動信号を補 助スイッチング素子Q2に供給するように構成してもよ

【0018】前記補助スイッチング素子Q2の両端すな わちドレイン・ソース間には、コンデンサC2とダイオ ードD2が並列に接続される。このコンデンサC2はス イッチング素子Q2に内蔵する寄生キャパシタンスであ り、またダイオードD2はスイッチング素子Q2に内蔵 するボディダイオードであるが、外付けのコンデンサ素 子やダイオード素子を用いてもよい。また、電圧クラン プ用のコンデンサC5は、主スイッチング素子Q1の両 端間に並列接続される共振コンデンサC1よりも静電容 量の大きなものが選定される。なお、アクティブクラン プ回路21をスイッチング素子Q1の両端間に接続しても よい。

【0019】一方、絶縁コンバータトランスTの二次側 は、前述の整流ダイオードD5に代わって、MOS型F ETからなる整流スイッチング素子Q3が半波整流平滑 回路3を構成する整流素子として設けられる。この整流 スイッチング素子Q3は、内蔵するボディダイオードと してのダイオードD3が、ドレイン・ソース間に接続さ れる。また、整流スイッチング素子Q3を適切なタイミ ングでオンさせるために、前記主スイッチング素子Q1 のゲートへの駆動信号が立ち上がってから第1の所定時 間後に整流スイッチング素子Q3のゲートへの駆動電圧 を立ち上がらせ、主スイッチング素子Qlのゲートへの 駆動信号が立ち下がってから第2の所定時間後に整流ス イッチング素子Q3のゲートへの駆動電圧を立ち下がら せる遅延回路22が、前記駆動回路11に設けられる。なお 23は、トランスTの一次側にある制御回路7と、トラン スTの二次側にある整流スイッチング素子Q3との間の 信号伝送路を絶縁する絶縁素子である。その他の構成 は、図3に示す従来例と同じである。

【0020】次に、上記構成について、その作用を図2 の波形図を参照して説明する。なお、この図2におい て、最上段は主スイッチング素子QIのドレイン電流I Q1の波形であり、以下、主スイッチング素子Q1のドレ イン・ソース間電圧Vdsl、共振コンデンサC3の両端 間電圧VC3、整流スイッチング素子Q3を流れる電流 (但し、ダイオードD3を流れる分も加味する) IQ3、

主スイッチング素子Q1のゲート・ソース間電圧Vgs 1、整流スイッチング素子Q3のゲート・ソース間電圧 Vgs3の各波形を示している。

【0021】主スイッチング素子Q1は前述したよう に、出力電圧Voutの変動に伴なってスイッチング素子 Q1のゲートに供給するパルス駆動信号のオン時間が所 定の範囲で変化すると共に、このパルス駆動信号のオフ 時間はゼロボルト検出回路13により固定され、結果的に スイッチング素子Q1のスイッチング周波数が可変制御 される。これにより、広い制御範囲において出力電圧V outの定電圧化を図ることができると共に、最大負荷電 力の増大を図ることができる。

【0022】この主スイッチング素子Q1の一連の動作 において、図2に示すように、主スイッチング素子Q1 のゲートに供給する駆動信号(ゲート・ソース間電圧V gs1)がH(高)レベルからL(低)レベルに切り換わ る区間①になると、主スイッチング素子Q1および補助 スイッチング素子Q2がいずれもオフ状態になるデッド タイムに移行する。この区間①では、絶縁コンバータト ランスTの一次巻線Nplと共振インダクタンスLlが、 それまで主スイッチング素子Q1を通して流れていた電 流の連続性を維持するために、共振コンデンサC1に共 振電流を流し、共振コンデンサClは充電する一方で、 コンデンサC2, С5は放電する。これにより、共振イ ンダクタンスL1と共振コンデンサC1との間で電圧共 振を生じ、主スイッチング素子Qlのドレイン・ソース 間電圧Vds1はゼロから正弦波状に緩やかに立ち上が る。またこの共振時には、主スイッチング素子Q1のド レイン電流 I Q1はゼロであり、主スイッチング素子Q1 30 のターンオフ時のゼロ電圧スイッチング(ZVS)が達 成される。

【0023】やがて、主スイッチング素子Q1のドレイ ン・ソース間電圧Vdslが、入力電圧Vinとコンデンサ C5の両端間電圧を合計した値を越えると、ダイオード D2がオンして、共振インダクタンスL1および一次巻 線Nplからの慣性電流の殆どが、ダイオードD2を介し てコンデンサC5に流れ込む。このとき、コンデンサC 5の静電容量をコンデンサC1の静電容量よりも十分大 きく設定すれば、主スイッチング素子Qlのドレイン・ ソース間電圧Vdslは略一定値にクランプされ、主スイ 40 ッチング素子Q1に対する電圧ストレスが軽減される。 【0024】そして、次の区間②において、一次巻線N p2の非ドット側巻線に発生する電圧が所定レベルを越え ると、補助スイッチング素子Q2がターンオンするが、 そのタイミングはダイオードD2がオンした後、前記慣 性電流がゼロになるまでの間であればよい。

【0025】またその間、整流スイッチング素子Q3を 通してコンデンサC4や負荷RLへの電流IQ3は、主ス イッチング素子Q1をオフした時点から徐々に低下する 50 が、この電流 I Q3がゼロになる前に、制御回路 7 が整流 (5)

スイッチング素子Q3をターンオフするため、代わって ダイオードD3を通じて電流IQ3が流れ始める。整流ス イッチング素子Q3がターンオフするタイミングは、遅 延回路22により主スイッチング素子Q1をターンオフし てから第2の所定時間T2を経過した後となるが、この 所定時間T2の設定は、前記共振コンデンサC1と共振 インダクタンスLIの各定数で決まる共振周波数に依存 する。

【0026】やがて、共振インダクタンスし1や一次巻 線Nplの全エネルギーがコンデンサC5に移り、これら の共振インダクタンスLlや一次巻線Nplからの慣性電 流がゼロになると、絶縁コンバータトランスTの二次側 においても、ダイオードD3を流れる電流 IQ3がゼロに なり、ダイオードD3およびスイッチング素子Q3が共 にオフ状態となる区間③に移行する。この区間③におい ては、コンデンサC4に蓄えられた電荷により、負荷R Lに出力電流 I outが供給される。また、絶縁コンバー タトランスTの二次側では、電圧共振回路2を構成する 共振インダクタンスL3と共振コンデンサС3による電 圧共振が生じ、コンデンサC3の両端間電圧VC3は正弦 20 波状の電圧共振パルス波形となる。

【0027】その後、主スイッチング素子Q1がオンす る前に、補助スイッチング素子Q2を適当なタイミング でオフさせると、区間のに移行する。ここでは、共振イ ンダクタンスし1や一次巻線Nplが、それまで流れてい た電流の連続性を維持するために、直流電源Eを介して 共振コンデンサC1に共振電流を流す。これにより、共 振インダクタンスLIと共振コンデンサС 1との間で再 度電圧共振が生じ、主スイッチング素子Q1のドレイン ・ソース間電圧Vdslは正弦波状に低下する。これに伴 ない、主スイッチング素子Qlのドレイン・ソース間電 圧Vds1が入力電圧Vinよりも低くなると、絶縁インバ ータトランスTの一次巻線Nplはドット側端子に正極性 の電圧が印加され、他の一次巻線Np2や二次巻線Ns. Ns2のドット側端子も、それまでとは逆に正極性の電圧 が誘起されるようになる。そして、共振コンデンサC1 の電荷の放出が終了すると、今度はダイオード D 1 がオ ンするため、主スイッチング素子Qlのドレイン・ソー ス間電圧Vdslはゼロボルトに保たれる。なお、この区 間④の時点では、絶縁コンバータトランスTの二次側に おいて、電圧共振回路2による電圧共振が継続してい る。

【0028】前記ダイオードD1がオンした状態で、駆 動回路11からの駆動信号により主スイッチング素子Q1 をオンすると、区間⑤に移行するが、この時点では主ス イッチング素子Q1のドレイン・ソース間電圧 Vds1が ゼロボルトに保たれているので、ターンオフ時と同様に ターンオン時においても主スイッチング素子Qlのゼロ 電圧スイッチング(ZVS)が達成される。共振インダ いる間は、主スイッチング素子Q1を通して逆向きの電 流 I Q1が流れるが、やがて全てのエネルギーが直流電源 E側に戻ると、今度は直流電源Eから共振インダクタン スL1.一次巻線Npl、および主スイッチング素子Q1 を通して電流が流れる。また、区間⑤においても、絶縁 コンバータトランスTの二次側において、電圧共振回路 2による電圧共振が継続している。

【0029】やがて、制御回路7を構成する遅延回路22 は、駆動回路11が主スイッチング素子Q1をターンオン させた後に、第1の所定時間T1を経過した時点で整流 スイッチング素子Q3をターンオンさせる(区間⑥)。 この所定時間T1の設定は、前記共振コンデンサC3と 共振インダクタンス L 3 の各定数で決まる共振周波数に 依存する。整流スイッチング素子Q3がターンオンする 前に、前記電圧共振回路2による電圧共振で、コンデン サC3の両端間電圧VC3が出力電圧Voutを越えた時点 で、ダイオードD3がオンし、このダイオードD3を介 して平滑コンデンサC4や負荷RLに電力供給のための 電流 I Q3が流れ始める。そして、整流スイッチング素子 Q3がターンオンすると、今度は整流スイッチング素子 Q3を通して電流 IQ3が流れ、コンデンサC3の両端間 電圧VC3は出力電圧Voutと同じ値になる。その際、整 流スイッチング素子Q3の飽和電圧を、従来の整流ダイ オードD5の順方向電圧降下VFよりも低くなるように 選択すれば、特に出力電圧Voutが低く負荷電流loutの大 きい低出力大電流の複合電圧共振型スイッチング電源装 置において、従来の整流ダイオードD5を通じての電力 供給に比べて、絶縁コンバータトランスTの二次側整流 部における損失を低減でき、効率の向上を図ることがで きる。その後、主スイッチング素子Q1がターンオフす ると、区間①に戻って上述の動作を繰り返す。

【0030】以上のように本実施例によれば、主スイッ チング素子Q1のスイッチングにより絶縁コンバータト ランスTの一次巻線Nplに直流入力電圧を断続的に印加 し、この絶縁コンバータトランスTの二次巻線Nsに誘 起された交番電圧を整流平滑して所望の直流出力電圧V outを得ると共に、絶縁コンバータトランスTの一次側 と二次側にそれぞれ電圧共振回路1,2を有する複合共 振型スイッチング電源装置において、絶縁コンバータト ランスTの二次側にある整流素子として、前記主スイッ チング素子Q1に同期してオン・オフする整流スイッチ ング素子Q3を備えている。

【0031】この場合、絶縁コンバータトランスTの一 次側にある電圧共振回路1により、主スイッチング素子 Q1の両端間電圧を正弦波状のパルス波形にし、主スイ ッチング素子Q1のソフトスイッチングを行なう。ま た、絶縁コンバータトランスTの二次側にある別の電圧 共振回路2によって、絶縁コンバータトランスTの二次 巻線Nsに得られる交番電圧を正弦波状の共振電圧にす クタンスL1や一次巻線Nplにエネルギーが蓄えられて 50 る。その際、絶縁コンバータトランスTの二次側整流部 (6)

を構成する整流素子として、ダイオード素子ではなく整 流スイッチング素子Q3を用いているので、出力電圧V outの低い複合電圧共振型スイッチング電源装置であっ ても、二次側整流部の効率ηsはさほど低下しない。よ って、従来に比べて絶縁コンバータトランスTの二次側 整流部による損失を低減し、効率の向上を図ることが可 能になる。

【0032】また本実施例では、補助スイッチング素子 Q2とコンデンサC5との直列回路により構成され、主 スイッチング素子Q1のオフ期間に補助スイッチング素 10 利用したが、他に絶縁ゲートバイポーラトランジスタ 子Q2をオンにして、この主スイッチング素子Q1の両 端間電圧すなわちドレイン・ソース間電圧Vdslをコン デンサC5の充放電により一定に保つアクティブクラン プ回路21を備えている。

【0033】この場合、主スイッチング素子Q1のオフ 期間には、アクティブクランプ回路21により主スイッチ ング素子Q1のドレイン・ソース間電圧Vds1が一定に 保たれる。したがって、主スイッチング素子Q1のオフ 期間において、この主スイッチング素子Qlの電圧スト レスを低減できる。

【0034】なお、本実施例では、絶縁コンバータトラ ンスTの二次側整流平滑回路として、整流スイッチング 素子Q3と平滑ダイオードC4とからなる半波整流平滑 回路3を設けたが、一対の整流スイッチング素子と平滑 ダイオードとからなる全波整流平滑回路を設けてもよ い。また、絶縁コンバータトランスTの一次側回路とし ては、実施例におけるシングルエンデッド型コンバータ に電圧共振回路 1 を備えたものの他に、ハーフブリッジ 型やフルブリッジ型コンバータに電流共振回路を備えた ものでもよい。この場合、共振電流が主スイッチング素 30 子Q1のオン時間中に発生するため、このオン時間を一 定にする手段を制御回路7に設ける必要があるが、電流 共振回路により主スイッチング素子を流れる電流が正弦 波状のパルス波形になって、同様に主スイッチング素子 のソフトスイッチングが達成される。また、絶縁コンバ

ータトランスTの二次側も、例えば二次巻線Nsと共振 コンデンサC3を直列に接続した電流共振回路によっ て、絶縁コンバータトランスTの二次巻線Nsからの電 流を正弦波状の共振電流にするように構成してもよい。 【0035】以上、本発明の複合電圧共振型スイッチン グ電源装置について前記実施例に基づき説明してきた が、本発明は前記実施例に限定されるものではなく、種 々の変形実施が可能である。例えば、前記実施例におい

ては、主スイッチング素子Q1としてMOS型FETを (IGBT) や、バイポーラ接合トランジスタ(BJ T) などの各種半導体スインチング素子を利用してもよ

#### [0036]

【発明の効果】本発明の請求項1記載の複合共振型スイ ッチング電源装置によれば、絶縁コンバータトランスの 二次側整流部による損失を低減し、効率の向上を図るこ とができる。

【0037】また、本発明の請求項2記載の複合共振型 20 スイッチング電源装置によれば、主スイッチング素子の オフ期間において、この主スイッチング素子の電圧スト レスを低減できる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例を示す複合共振型スイッチン グ電源装置の回路図である。

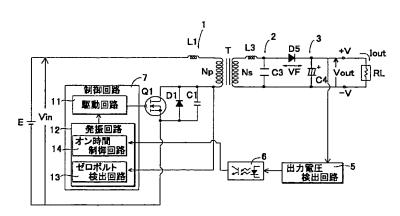
【図2】同上各部の波形図である。

【図3】従来の複合電圧共振型スイッチング電源装置の 回路図である。

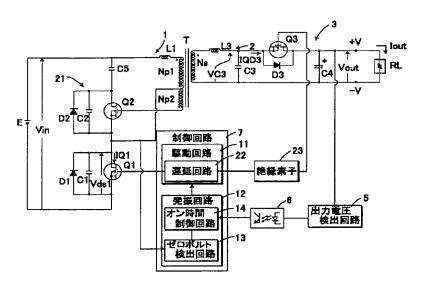
#### 【符号の説明】

- 1, 2 電圧共振回路(共振回路)
  - 21 アクティブクランプ回路
  - Q1 主スイッチング素子
  - Q3 整流スイッチング素子
  - T 絶縁コンバータトランス

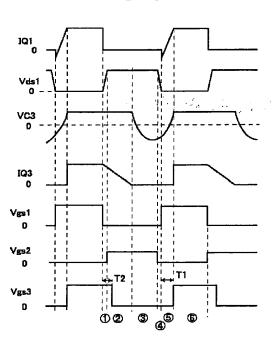
【図3】



【図1】



【図2】



THIS PAGE BLANK (USOT